

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: RFT

Wykonanie: tranzystor polowy MOS (kanał typu P normalnie wyłączony) w obudowie plastikowej z zabezpieczającą diodą scaloną, ciężar około 0,3 G

Zastosowanie: układy cyfrowe

Typy podobne: MEM517 (GI)

Rys. 1-1064. SMY52

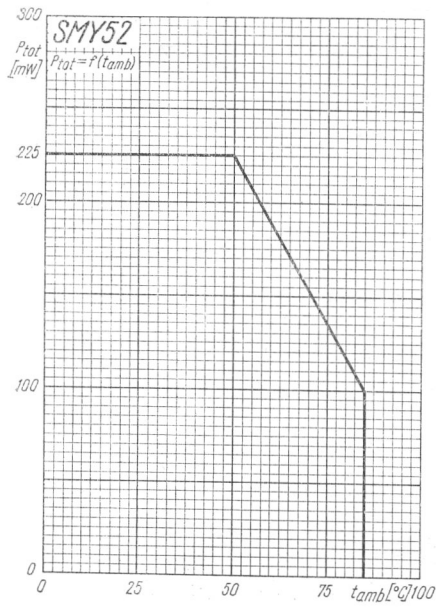
Wartości charakterystyczne¹⁾

	min	typ	max		
$-I_D$	20			mA	przy $-U_{DS} = 2 \text{ V}$, $-U_{GS} = 10 \text{ V}$, $-U_{SB} = 0$
$-I_D$		50		mA	przy $-U_{DS} = 10 \text{ V}$, $-U_{GS} = 10 \text{ V}$
$-U_T$	3			V	przy $U_{DS} = U_{GS}$, $-U_{SB} = 0$, $-I_D = 10 \mu\text{A}$
$-I_{GSS}$			10	μA	przy $-U_{DS} = 0$, $-U_{GS} = 31 \text{ V}$, $-U_{SB} = 0$
$-I_{GSS}$			0,20	μA	przy $-U_{DS} = 0$, $-U_{GS} = 20 \text{ V}$, $-U_{SB} = 0$
$-I_{DSS}$			10	μA	przy $-U_{DS} = 31 \text{ V}$, $-U_{GS} = 0$, $-U_{SB} = 0$
$-I_{DSS}$			0,20	μA	przy $-U_{DS} = 20 \text{ V}$, $-U_{GS} = 0$, $-U_{SB} = 0$
$-I_{SBS}$			0,20	μA	przy $-U_{SB} = 15 \text{ V}$, $-U_{DB} = 0$, $-U_{GS} = 0$
$-C_{gss}$			38	pF	przy $-U_{DS} = 0$, $-U_{GS} = 0$, $-U_{SB} = 0$
γ_{21}		-12,5		mS	przy $-U_{DS} = -U_{GS} = 10 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$
R_{DS}		35		Ω	przy $-I_D = 100 \mu\text{A}$, $-U_{GS} = 20 \text{ V}$

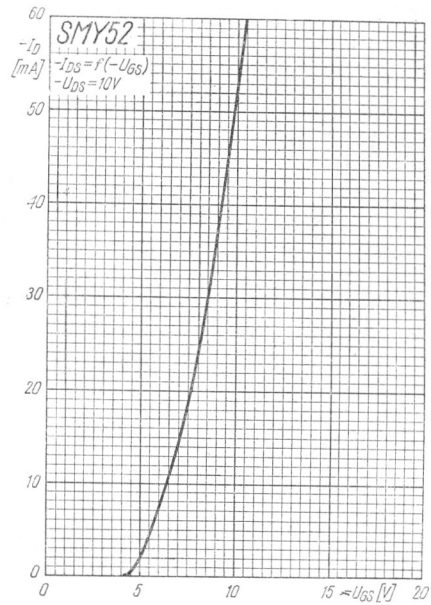
Wartości graniczne

$-U_{DS} \text{ max}$	31 ÷ -0,3	V	$-I_{DM} \text{ max}$	120	mA
$-U_{GS} \text{ max}$	31 ÷ -0,3	V	$I_G \text{ max}$	1	mA
$-U_{DG} \text{ max}$	31 ÷ -0,3	V	$I_{GSM} \text{ max}$	2	mA
$-U_{SB} \text{ max}$	15 ÷ -0,3	V	$P_{tot} \text{ max}$	300 ¹⁾	mW
$-U_{GB} \text{ max}$	31 ÷ -0,3	V	t_{stg}	-40 ÷ +125	°C
$-U_{DB} \text{ max}$	31 ÷ -0,3	V	t_{amb}	-25 ÷ +85	°C
$-I_D \text{ max}$	60	mA			

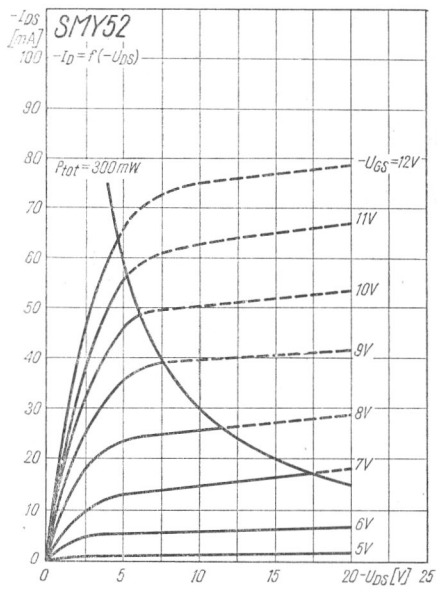
¹⁾ $t_{amb} = 25^\circ\text{C}$



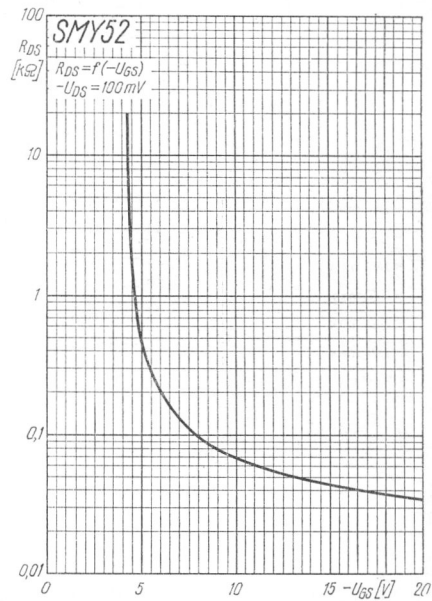
Rys. 1-1065. Zależność dopuszczalnej mocy strat od temperatury otoczenia



Rys. 1-1066. Charakterystyka wejściowa



Rys. 1-1067. Charakterystyki wyjściowe



Rys. 1-1068. Zależność rezystancji R_{DS} od napięcia bramki